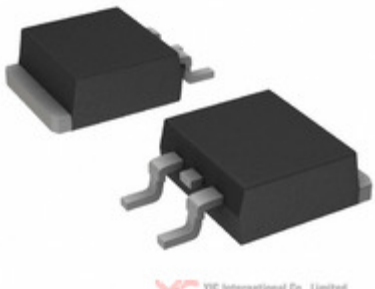

	<h2 style="color: red;">FQB5N80TM</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FQB5N80TM
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 800V 4.8A D2PAK
	Datenblätter:  FQB5N80TM.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	



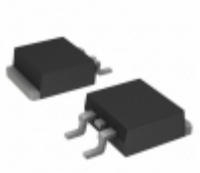

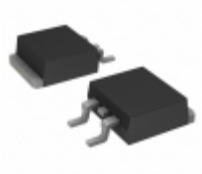


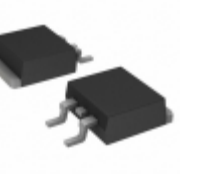
Spezifikationen

Teilenummer	FQB5N80TM
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 800V 4.8A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D ² PAK (TO-263AB)
Serie	QFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 Ohm @ 2.4A, 10V
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 140W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D ² Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1250pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	800V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 800V 4.8A (Tc) 3.13W (Ta), 140W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.8A (Tc)

FQB5N80TM Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FQB5N80TM-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FQB5N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FQB5N80TM E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>FQB5N90 FAIRCHILD FQB5N90 FAIRCHILD</p>	 <p>FQB5N90TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.4A D2PAK</p>	 <p>FQB5N60CTM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N60TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5A D2PAK</p>
 <p>FQB5N60TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 5A D2PAK</p>	 <p>FQB5N60CTM_WS Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A</p>	 <p>FQB5N90TM Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 900V 5.4A D2PAK</p>	 <p>FQB5N60CTM-WS AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 4.5A</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FQB5N80TM AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FQB5N80TM Datenblatt	FQB5N80TM-Datenblätter	FQB5N80TM PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FQB5N80TM
FQB5N80TM Electronic	FQB5N80TM-Komponenten	FQB5N80TM-Verteiler	FQB5N80TM-Bild	FQB5N80TM-Teil
FQB5N80TM Preis	FQB5N80TM Hersteller	FQB5N80TM Bild	FQB5N80TM Aktie	FQB5N80TM Inventar
FQB5N80TM Neu	FQB5N80TM Original	FQB5N80TM garantiert	FQB5N80TM RFQ	FQB5N80TM Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited